

证书号第 3785644 号



# 发明专利证书

发明名称：一种有两种载流子导电的超结功率 MOSFET

发明人：林智;袁琦;韩姝;胡盛东;周建林;唐枋;周喜川

专利号：ZL 2018 1 0137190.X

专利申请日：2018 年 02 月 10 日

专利权人：重庆大学

地址：400044 重庆市沙坪坝区正街 174 号

授权公告日：2020 年 05 月 05 日

授权公告号：CN 108288649 B

国家知识产权局依照中华人民共和国专利法进行审查，决定授予专利权，颁发发明专利证书并在专利登记簿上予以登记。专利权自授权公告之日起生效。专利权期限为二十年，自申请日起算。

专利证书记载专利权登记时的法律状况。专利权的转移、质押、无效、终止、恢复和专利权人的姓名或名称、国籍、地址变更等事项记载在专利登记簿上。



局长  
申长雨

申长雨





证书号 第 3785644 号



专利权人应当依照专利法及其实施细则规定缴纳年费。本专利的年费应当在每年 02 月 10 日前缴纳。未按照规定缴纳年费的，专利权自应当缴纳年费期满之日起终止。

申请日时本专利记载的申请人、发明人信息如下：

申请人：

重庆大学

发明人：

林智；袁琦；韩姝；胡盛东；周建林；唐枋；周喜川